

(19) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
INSTITUT NATIONAL  
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE  
PARIS

(11) N° de publication :  
(à n'utiliser que pour les  
commandes de reproduction)

2 917 543

(21) N° d'enregistrement national : 07 04168

(51) Int Cl<sup>8</sup> : H 01 S 3/14 (2006.01)

(12)

## DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

(22) Date de dépôt : 12.06.07.

(30) Priorité :

(43) Date de mise à la disposition du public de la demande : 19.12.08 Bulletin 08/51.

(56) Liste des documents cités dans le rapport de recherche préliminaire : Se reporter à la fin du présent fascicule

(60) Références à d'autres documents nationaux apparentés :

(71) Demandeur(s) : COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES LASERS CILAS Société anonyme — FR.

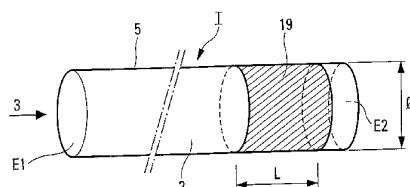
(72) Inventeur(s) : RAPAPORT ALEXANDRA, NGUYEN LUC et MONTAGNE JEAN EUCHER.

(73) Titulaire(s) :

(74) Mandataire(s) : CABINET BONNETAT.

(54) ELEMENT ACTIF POUR SOURCE LASER ET SOURCE LASER COMPORTANT UN TEL ELEMENT ACTIF.

(57) - Elément actif pour source laser et source laser comportant un tel élément actif.  
- Selon l'invention, la surface latérale (5) du barreau dopé (2) comporte au moins une zone diffusante (19) apte à interrompre les trajets des modes laser parasites.



FR 2 917 543 - A1



La présente invention concerne un élément actif pour source laser, ainsi qu'une source laser comportant un tel élément actif.

Plus précisément, ladite source laser est du type comportant :

- un élément actif comprenant un barreau allongé, de section transversale généralement circulaire, mais non exclusivement, comportant une matrice dopée susceptible d'absorber un faisceau de pompage se propageant longitudinalement pour amplifier un rayonnement laser se propageant également longitudinalement ;
- un système de pompage, comportant des diodes (laser) de pompage susceptibles d'émettre ledit faisceau de pompage longitudinal ;
- un système optique de transport pour diriger le faisceau de pompage émis par ledit système de pompage dans ledit élément actif de manière à obtenir un pompage longitudinal ; et
- une cavité optique permettant d'extraire ledit rayonnement laser.

On sait que, pour être efficace, le faisceau de pompage doit être spectralement accordé au spectre d'absorption de l'élément actif de telle sorte que ledit faisceau de pompage soit absorbé et transfère son énergie vers l'ion (terre rare ou métal de transition par exemple) dopant ledit élément actif.

On sait également que les diodes (laser) de pompage présentent un spectre d'émission, généralement de quelques nanomètres de large, qui se décale de 0,25 à 0,3 nanomètre par degré Celsius, lorsque l'on fait varier la température desdites diodes de pompage.

Pour assurer une conformité satisfaisante de la longueur d'onde du faisceau de pompage (issu desdites diodes de pompage) avec le spectre d'absorption du milieu actif, il est connu de monter lesdites diodes sur des

modules Peltier, dont la fonction est de stabiliser leur température à mieux que 0,5°C, de sorte qu'un centrage de longueur d'onde est assuré à au moins 0,2 nm.

Toutefois, notamment dans le cadre d'applications militaires, les 5 paramètres de compacité, de consommation d'énergie et de rapidité de mise en œuvre revêtent une importance particulière. Aussi, l'utilisation de modules Peltier, qui induit une consommation d'énergie importante et qui nécessite un temps de stabilisation de l'ordre de la minute, est un frein à l'emploi de sources laser pompées par diode(s) dans des systèmes compacts. Il en va de même pour d'autres systèmes de stabilisation actifs de 10 la température des diodes. Aussi, la technologie toujours mise en œuvre actuellement, par exemple pour des désignateurs laser terrestres, est une technologie de pompage par flash, qui est peu rentable et encombrante.

Pour essayer de remédier à ce problème, il convient donc :

- 15 – soit d'augmenter la tolérance de l'élément actif à la dérive de longueur d'onde, ce qui est proposé par exemple par le brevet FR-2 803 697, pour lequel le faisceau de pompage est guidé pour passer plusieurs fois à travers l'élément actif ;
- soit de mettre en œuvre une stabilisation passive de la longueur d'onde 20 d'émission des diodes de pompage, comme proposé par exemple dans la demande de brevet US-2005/0018743 qui décrit l'utilisation d'un système incluant un ou plusieurs Réseaux de Bragg en Volume (RBV ou VBG, pour "Volume Bragg Grating" en anglais) afin de conditionner une ou plusieurs caractéristiques d'émission du laser.

Toutefois, les solutions précédentes permettent uniquement d'obtenir une insensibilité de 3 à 10 nanomètres correspondant à une dérive de température des diodes de 15 à 40°C. Une telle plage d'insensibilité thermique est largement insuffisante pour utiliser le système de pompage, par exemple dans un désignateur laser terrestre, entre -40°C et +70°C.

La présente invention a pour objet de fournir un élément actif et une source laser permettant d'obtenir une insensibilité thermique de l'émission laser sur plus de 15 nanomètres.

On sait que la proportion d'énergie de pompage absorbée par l'élément actif dépend, d'une part, du coefficient d'absorption  $\alpha(\lambda)$  de l'élément actif et, d'autre part, de la longueur de matériau  $L$ , traversée par le faisceau de pompage. Cette proportion d'énergie absorbée  $Abs$  vérifie la relation  $Abs(\lambda) = 1 - \text{Exp}[-\alpha(\lambda)L]$  dans le cas d'un matériau homogène ou  $Abs(\lambda) = 1 - \text{Exp}[-\alpha_1(\lambda)L_1 - \alpha_2(\lambda)L_2 - \dots - \alpha_n(\lambda)L_n]$  dans le cas d'un matériau composé de  $n$  zones d'absorption  $\alpha_i(\lambda)$  et de longueur  $L_i$  et  $Abs(\lambda) = 1 - \text{Exp}[-\int \alpha(\lambda, z) dz]$  dans le cas le plus général où le dopage et l'absorption varient dans le barreau en fonction de la position longitudinale  $z$ ,  $\lambda$  désignant la longueur d'onde de l'émission laser. Aussi, pour optimiser ladite proportion  $Abs$ , il convient de maximiser, d'une part, ledit coefficient d'absorption  $\alpha$  pour toutes les longueurs d'onde intéressantes et, d'autre part, ladite longueur traversée par le faisceau de pompage. Afin que la proportion  $Abs$  reste toujours supérieure à environ 80-90% pour l'ensemble de la plage spectrale visée, il faut que la longueur d'absorption soit adaptée au coefficient le plus faible.

On sait, par ailleurs, qu'il est difficile d'extraire convenablement l'énergie d'un grand volume d'élément actif, dans lequel l'énergie de pompage serait dispersée. Aussi, il est avantageux de mettre en œuvre une configuration de pompage longitudinal, pour laquelle la longueur d'absorption du faisceau de pompage peut être longue, pourvu que celui-ci soit colinéaire (ou quasiment) à l'axe de la source laser. L'élément actif est donc alors adapté pour recevoir et véhiculer une radiation de pompage se propageant de manière colinéaire (ou quasiment) à l'axe de la source laser.

La principale difficulté d'un pompage longitudinal à des niveaux élevés de puissance (supérieurs à 500 W), lorsqu'on veut faire un laser

- déclenché, réside dans la production d'effets parasites, tels qu'une amplification d'émission spontanée (amplification ASE ci-après) ou des modes d'émission parasites (modes MEP ci-après). L'amplification ASE provient d'une radiation spontanée, naturellement émise par les ions excités par le faisceau de pompage et amplifiée par le gain résultant de la présence de ces ions excités. Les modes MEP, quant à eux, proviennent de la combinaison :
- de réflexions présentes aux bords de l'élément actif et/ou sur tout autre réflecteur ; et
  - du gain laser provenant des ions excités.

La combinaison de ces deux facteurs engendre une émission laser parasite suivant un ou plusieurs axes qui sont habituellement distincts de l'axe laser principal.

L'amplification ASE est un paramètre gouverné essentiellement par le gain et la longueur maximale de gain possible dans l'élément actif. La seule possibilité de diminuer son effet est de limiter la longueur de gain ou la valeur du gain.

En outre, les modes MEP sont gouvernés par le gain et la présence de réflexions parasites qui renvoient des photons vers le laser et permettent ainsi un cyclage à gain de ces photons.

La présente invention a pour objet de remédier à ces inconvénients. Elle concerne un élément actif pour source laser, permettant d'obtenir une insensibilité thermique importante, tout en limitant la génération d'effets parasites du type précité (amplification ASE et modes MEP).

A cette fin, selon l'invention, l'élément actif pour source laser, comportant :

- un barreau allongé à surface latérale réfléchissante, dopé pour être susceptible d'absorber au moins un faisceau de pompage se propageant au moins approximativement longitudinalement dans ledit barreau afin

d'amplifier au moins un rayonnement laser se propageant également longitudinalement ; et

- une enveloppe au contact de ladite surface latérale dudit barreau et présentant un indice de réfraction plus petit que celui dudit barreau,
- 5 est remarquable en ce que :
- ladite enveloppe est apte à réfléchir au moins 80% dudit faisceau de pompage dans ledit barreau ;
  - la longueur et le dopage dudit barreau sont tels que la fraction de l'énergie dudit faisceau de pompage, absorbée par ledit barreau, est au moins 10 égale à 80% ; et
  - dans ladite surface latérale réfléchissante dudit barreau, est pratiquée au moins une zone diffusante apte à interrompre les trajets de modes laser parasites se propageant dans ledit barreau par réflexions totales internes sur ladite surface latérale.

15 Ainsi, grâce à la présente invention, on peut obtenir un pompage particulièrement efficace sur une plage spectrale de plus d'une vingtaine de nanomètres, ainsi qu'une suppression très importante, sinon totale, des rayonnements parasites qui ont tendance à se développer dans ledit barreau, ce qui permet d'interdire les modes MEP et de minimiser la longueur 20 d'amplification ASE.

Lorsque la surface latérale du barreau est polie pour être réfléchissante, ladite zone diffusante peut correspondre à une zone dépolie (ou non polie) de ladite surface latérale. Cette zone dépolie doit empêcher toute réflexion spéculaire et elle peut être obtenue par tout moyen connu tel que abrasion, attaque chimique, ultrasons, sablage, cannelage, etc ...

25 Quelle que soit la nature de ladite zone diffusante, son étendue totale sur la surface latérale dudit barreau est au moins approximativement comprise entre 5% et 40% de la surface latérale dudit barreau.

Pour expliquer le mode d'élimination des modes MEP par ladite zone diffusante, on peut prendre l'exemple d'un barreau cylindrique dans lequel on distingue les modes MEP 2D (modes MEP à deux dimensions) et les modes MEP 3D (modes MEP à trois dimensions).

5 Les modes MEP 2D se développent dans une section du barreau en suivant des trajets en forme de polygone, chaque sommet du polygone constituant un rebond sur la périphérie du barreau. Plus l'indice de l'enveloppe est faible, plus le nombre de MEP 2D polygonaux existants est fort. Par exemple, pour un barreau en YAG( $n=1.82$ ) placé dans de l'air ( $n=1$ ),  
10 le MEP 2D carré existe en réflexion totale, ainsi que tous les MEP 2D polygonaux d'ordre supérieur (pentagone, hexagone, ...). Plus l'indice de l'enveloppe est proche de celui du barreau, plus l'incidence des MEP 2D sur la face du barreau est rasante pour conserver un fort coefficient de réflexion. Pour un indice donné de l'enveloppe, les modes MEP 2D ont un  
15 angle limite de réflexion en dessous duquel ils subissent trop de pertes pour exister. Associée à cet angle, il y a une taille du côté déterminé du MEP polygonal. Si on réalise une zone diffusante d'une fraction de la périphérie supérieure à cette taille déterminée de ce côté, alors on supprime les MEP 2D existant dans cette section.

20 Les modes MEP 3D se développent également selon une forme polygonale qui rebondit sur la périphérie interne du barreau, si on regarde leur trace dans une section du barreau, mais ils ont, en plus, une propagation longitudinale qui les amène à rebondir également sur les faces extrêmes dudit barreau. Leur trajet s'apparente à une spirale segmentée. L'existence de tels modes MEP 3D dépend de leur incidence sur les faces extrêmes, de leur incidence sur la périphérie et de l'indice de l'enveloppe.  
25 Afin de supprimer de tels modes MEP 3D, une solution consiste à disposer la zone diffusante à la périphérie du barreau sur une longueur telle que le

pas du mode MEP 3D enjambant cette zone possède une incidence sur la face extrême telle que la perte par réflexion l'empêche d'exister.

De ce qui précède, on comprendra aisément qu'une partie de zone diffusante, de forme annulaire autour dudit barreau, peut éliminer les modes MEP 3D qui se développent en spirale. En effet, à cause de cette partie annulaire de zone diffusante, les modes MEP 3D ne peuvent ni parcourir tout le barreau, ni parvenir aux extrémités de celui-ci pour se réfléchir sur les faces d'extrémité. Pour des raisons d'efficacité, l'étendue longitudinale de ladite partie annulaire de zone diffusante doit être au moins égale au diamètre du barreau.

Pour éviter que ladite partie annulaire de zone diffusante ne nuise à la propagation du faisceau de pompage, on la dispose de préférence dans une portion du barreau dans laquelle ne transite qu'un faible flux de faisceau de pompage. Par exemple :

- 15 – si un faisceau de pompage est adressé audit barreau par une seule de ses faces d'extrémité longitudinale, ladite partie annulaire de zone diffusante est disposée au voisinage de l'autre desdites faces d'extrémité longitudinale du barreau ;
- si un faisceau de pompage est adressé audit barreau par chacune de ses faces d'extrémité longitudinale, ladite partie annulaire de zone diffusante est disposée au voisinage de la partie médiane du barreau.

Dans ces cas, l'étendue longitudinale de ladite partie annulaire de zone peut être très supérieure au diamètre du barreau.

On remarquera qu'une telle partie annulaire de zone diffusante ne peut éliminer tous les modes MEP 2D se propageant dans des sections du barreau et ne peut donc être satisfaisante vis-à-vis de l'élimination de ces derniers que dans des cas particuliers, comme par exemple faible gain, indice de réfraction des moyens d'enveloppe proche de l'indice de réfraction du barreau, ...

Aussi, afin d'éliminer les modes MEP 2D de façon certaine, ladite zone diffusante comporte de plus au moins une partie en forme de bande, dont la direction générale est au moins approximativement longitudinale par rapport audit barreau, apte à interrompre les trajets laser parasites 5 bouclés à l'intérieur de celui-ci. Une telle partie en forme de bande peut suivre une génératrice dudit barreau, s'enrouler en spirale autour de celui-ci, être constituée d'une pluralité de segments individuels disposés sur des génératrices différentes du barreau, etc ... Eventuellement, cette partie en forme de bande peut n'être prévue que dans les zones du barreau à fort dopage.

La largeur de la partie en forme de bande de ladite zone diffusante doit être supérieure à la distance séparant deux réflexions internes consécutives du mode MEP 2D de plus petit ordre, à l'intérieur dudit barreau. Cette largeur se détermine facilement par le calcul à partir de l'incidence 15 par rapport à la surface latérale et des indices de réfraction du barreau et de l'enveloppe. Par exemple, pour un barreau en YAG:Nd, d'indice égal à 1,82, et une enveloppe d'indice égal à 1,65, on détermine que ledit plus petit ordre est égal à 8. La largeur de ladite bande doit donc être égale au 1/8 de la surface latérale du barreau.

De préférence, ladite enveloppe est formée par un film fluide et, pour des raisons de transmission thermique, son épaisseur est au plus égale à  $500 \mu\text{m}$ . Ce film peut être liquide (polyphényl éther), ou bien constitué par une colle, par un gel ou par une graisse (graisse thermique translucide ou graisse à vide translucide). Avantageusement, cette enveloppe 25 est absorbante pour au moins l'une des radiations émises par le barreau.

Avantageusement également, au-delà de cette enveloppe, la tenue mécanique, incluant à la fois l'enveloppe et l'élément actif (barreau), peut être absorbante pour les radiations lasers afin de minimiser les effets para-

sites. A cette fin, une anodisation noire de l'intérieur du canal contenant barreau et enveloppe est préférable.

La présente invention concerne également une source laser comportant :

- 5 – un élément actif pour source laser ;
- un système de pompage muni de diodes laser de pompage qui sont susceptibles d'émettre au moins un faisceau de pompage ;
- un système optique de transport pour diriger le faisceau de pompage émis par lesdites diodes laser dans ledit élément actif de manière à obtenir un pompage longitudinal ; et
- 10 – une cavité optique permettant d'extraire au moins un rayonnement laser.

Selon l'invention, ladite source laser est remarquable en ce que ledit élément actif est du type précité.

15 De façon avantageuse, ledit système de pompage est formé de manière à engendrer un faisceau de pompage :

- qui comporte une stabilité de l'énergie déposée stable à plus de 20% sur plusieurs dizaines de degrés ; et/ou
- qui est compris dans un angle solide prédéterminé relatif audit barreau.

20 Dans un mode de réalisation particulier, ledit système de pompage comporte des modules (ou empilements) de diodes, formés de semi-conducteurs issus de différents disques (waffers). La somme des émissions spectrales des différents semi-conducteurs engendre ainsi un spectre plus large que celui d'une diode unique. De plus, avantageusement, chaque module de diodes comporte un moyen de refroidissement, ce qui permet d'obtenir une situation thermique spécifique et un fonctionnement 25 également étalé du spectre.

Par ailleurs, de façon avantageuse, ladite source laser peut comporter, de plus, des moyens pour engendrer au moins un double passage du faisceau de pompage dans l'élément actif.

Ledit système de pompage peut être composé de deux blocs, chacun apportant une radiation de pompage par chacune des deux extrémités du barreau, afin de répartir de manière plus homogène le dépôt énergétique sur la longueur du barreau et réduire de cette manière la propension des modes MEP et de l'amplification ASE à se développer dans les plans d'entrée du barreau.

Les figures du dessin annexé feront bien comprendre comment l'invention peut être réalisée. Sur ces figures, des références identiques désignent des éléments semblables.

La figure 1 est le schéma synoptique d'une source laser connue.

La figure 2 illustre schématiquement les modes d'émission laser parasites à deux et à trois dimensions à l'intérieur de l'élément actif de la source laser de la figure 1.

Les figures 3, 4 et 5 illustrent schématiquement trois exemples de l'élément actif conforme à la présente invention.

La figure 6 est un diagramme du spectre d'absorption d'un matériau YAG dopé Néodyne à 1%, l'axe des abscisses portant les longueurs d'onde  $\lambda$  (en nm) et l'axe des ordonnées indiquant le coefficient d'absorption  $\alpha$  (en  $\text{cm}^{-1}$ ).

L'élément actif 1, de type connu et représenté schématiquement sur la figure 1, comporte un barreau allongé 2 qui comprend une matrice dopée susceptible d'absorber un faisceau de pompage 3, pour amplifier au moins un rayonnement laser 4 se propageant longitudinalement selon un axe X-X. La surface latérale 5 du barreau 2 est polie (donc réfléchissante) et recouverte d'une enveloppe 6 présentant un indice de réfraction plus petit que celui dudit barreau. Ainsi, le faisceau de pompage 3 peut être

maintenu dans le barreau 2 grâce à des réflexions totales internes sur ladite surface latérale 5.

Cet élément actif 1 peut être intégré dans une source laser 7 telle que représentée à titre d'exemple sur la figure 1.

5 Ladite source laser 7 comporte, de façon usuelle, en plus dudit élément actif 1 :

- un système de pompage 8 usuel, qui comprend des diodes de pompage 8A de type laser et qui est susceptible d'émettre au moins un faisceau de pompage 3 ;
- 10 – un système optique de transport 9 usuel, pour diriger le faisceau de pompage 3 émis par ledit système de pompage 8 dans ledit élément actif 1 de manière à obtenir un pompage longitudinal, à travers une face d'extrémité E1 dudit barreau 2 ; et
- une cavité optique 10 usuelle, d'axe X-X, comprenant notamment un 15 miroir réfléchissant 11 et un miroir 12 partiellement transparent, qui sont placés en regard l'un de l'autre. Cette cavité optique 10 confère au rayonnement laser 4, obtenu par l'amplification laser et émis à travers ledit miroir 12 selon l'axe X-X, ses caractéristiques de directivité et de géométrie. Ladite cavité optique peut également contenir des moyens 20 de déclenchement usuels (QSwitch), non représentés sur la figure 1, de type électro-optique ou acousto-optique par exemple.

Comme cela est illustré schématiquement sur la figure 2, en fonctionnement, le barreau 2 (représenté sans son enveloppe 6) est le siège d'émissions laser parasites. Selon un premier mode, dit mode MEP 2D (voir ci-dessus), ces émissions laser parasites se développent dans des sections 14 du barreau 2 en suivant des trajets en forme de polygone 15, chaque sommet 16 d'un polygone 15 constituant un rebond par réflexion interne sur la surface latérale 5. Selon un autre mode, dit mode MEP 3D (voir ci-dessus), ces émissions laser parasites suivent des spirales segmen-

tées 17 se propageant longitudinalement dans ledit barreau 2, avec des points 18 de rebond 11 par réflexion interne sur la surface latérale 5.

Selon une particularité importante de la présente invention, afin d'éliminer de tels modes parasites MEP 3D, on dépoli la surface latérale 5 selon une zone annulaire 19 entourant ledit barreau 2, comme dans l'élément actif I montré à titre d'exemple (sans l'enveloppe 6) par la figure 3. La zone annulaire dépolie 19 de la surface latérale 5 est donc diffusante et élimine les points de rebond 18. On obtient de bons résultats pour l'élimination des modes MEP 3D lorsque l'étendue longitudinale L de la zone annulaire diffusante 19 est au moins égale au diamètre  $\phi$  du barreau 2.

Comme indiqué ci-dessus, la zone annulaire diffusante 19 est de préférence disposée dans une portion du barreau dans laquelle ne transite qu'un faible flux du faisceau de pompage 3. Aussi, dans l'exemple de la figure 3, où l'on a supposé que, comme dans la source laser 7 de la figure 1, le faisceau de pompage 3 est adressé au barreau 2 par la seule face d'extrémité E1 de ce dernier, ladite zone annulaire diffusante 19 est disposée au voisinage de l'autre face d'extrémité E2 dudit barreau 2.

Par ailleurs, afin d'éliminer les modes parasites MEP 2D, selon une autre particularité de la présente invention –voir le mode de réalisation II de la figure 4– on dépoli la surface latérale 5 du barreau 2 selon une portion de bande 20, de direction générale au moins approximativement longitudinale par rapport à celui-ci. La largeur  $\ell$  de ladite portion de bande diffusante 20 ainsi obtenue est au moins égale à la longueur a (voir la figure 2) d'un côté du polygone 15 correspondant au mode MEP 2D de plus petit ordre. Bien que représentée rectiligne et d'un seul tenant sur la figure 4, ladite portion de bande 20 pourrait être discontinue et/ou présenter toute forme (hélice, par exemple) désirée.

Dans la variante de réalisation III de l'élément actif conforme à la présente invention, représentée sur la figure 5, le barreau 2 est pompé à

travers chacune de ses faces d'extrémité E1 et E2, respectivement par des faisceaux de pompage 3.1 et 3.2. Dans ce cas, la zone annulaire diffusante 19 est avantageusement disposée dans la partie médiane dudit barreau 2 (là où ne transite qu'un faible flux de pompage) et une portion de bande 20.1, 20.2 (analogue à la portion de bande 20) peut être prévue de part et d'autre de ladite zone annulaire diffusante médiane 19.

Quelle que soit sa configuration, la zone diffusante 19, 20, 20.1, 20.2 s'étend sur ledit barreau 2 sur une fraction de ladite surface latérale 5 de celui-ci au moins approximativement comprise entre 5% et 40%.

Par ailleurs, l'enveloppe 6 au contact de la surface latérale 5 du barreau 2 est choisie pour être apte à réfléchir au moins 80% du faisceau de pompage 3 dans le barreau 2. Bien entendu, cette enveloppe 6 doit présenter un indice de réfraction inférieur à celui du barreau 2 et être peu absorbante pour le faisceau de pompage 3, 3.1, 3.2, de telle sorte que la réflexion totale à son interface avec le barreau 2 s'effectue avec l'efficacité maximale. En revanche, ladite enveloppe 6 peut être préférentiellement absorbante pour les radiations laser.

Une telle enveloppe est avantageusement formée par un film fluide. Elle peut par exemple être composée par une colle qui assure une jonction thermique et mécanique entre le barreau et la monture (non représentée) qui l'entoure, sans que cette colle ait forcément des caractéristiques d'accrochage prononcées. Cette enveloppe périphérique 6 peut également être composée d'un liquide d'indice, d'un gel ou d'une graisse. Pour que la fonction de transfert thermique entre le barreau et sa monture soit bonne, on préférera une épaisseur d'enveloppe inférieure à 500 $\mu\text{m}$ .

Par ailleurs, la longueur et le dopage du barreau 2 sont tels que la fraction de l'énergie du faisceau de pompage 3, absorbée par le barreau 2, est au moins égale à 80% sur une gamme spectrale supérieure à 15 nanomètres. Le barreau 2 peut présenter une variation longitudinale de do-

page, selon l'axe X-X, avec le dopage le plus faible qui est limité à une valeur prédéterminée, par exemple 0,1%, au niveau de la ou des face(s) d'extrémité E1, E2 d'entrée du faisceau de pompage 3.1, 3.2 dans l'élément actif 1.

5           Ainsi, en limitant le dopage en entrée(s) du barreau 2, on limite l'absorption, et donc le gain transverse, dans cette zone, ce qui permet de réduire l'apparition à la fois d'une amplification ASE et de modes MEP. Le matériau du barreau 2 doit particulièrement respecter ce critère lorsque la longueur d'onde de pompage est située au maximum d'absorption dudit 10 matériau.

La baisse de dopage en entrée(s) du barreau 2 diminue l'efficacité d'absorption, en particulier lorsque la longueur d'onde de pompage est située au minimum d'absorption dudit matériau dans la bande spectrale considérée. Il importe donc de prévoir, au-delà d'une distance prédéterminée, par exemple quelques millimètres en aval de la ou des faces d'entrée E1, E2, un niveau de dopage plus élevé.  
15

Le matériau du barreau 2 peut présenter une variation longitudinale de dopage continue, ou une variation longitudinale de dopage par pas.

Dans le premier cas, ledit matériau est de préférence un matériau à 20 gradient de dopage. De tels matériaux peuvent être réalisés par procédé céramique.

Il est également possible d'utiliser plusieurs cristaux de dopage progressif pour atteindre à l'entrée de chacun de ces derniers le gain maximal de démarrage de l'amplification ASE.

25           Pour les barreaux composés d'un seul dopage et d'une seule matrice ou de plusieurs dopages différents et/ou de plusieurs matrices différentes, afin d'obtenir une insensibilité à la variation de longueur d'onde des diodes, le matériau possède un dopage et une longueur tels, qu'avec un pompage longitudinal, la fraction absorbée Abs pour la longueur d'onde

la moins absorbante de la plage spectrale de fonctionnement est supérieure à environ 90%.

Dans le cas d'un matériau homogène, on a donc  $\text{Abs} = 1 - \text{Exp}[-\alpha(\lambda)L] > 90\%$ , soit  $\alpha(\lambda)L > 2.3$

5 Dans le cas représenté en exemple sur la figure 6 d'un YAG dopé Néodyme à 1% où  $\alpha(\lambda=802\text{nm}) = 0.6\text{cm}^{-1}$  au minimum d'absorption, il faut que la longueur de matériau dopé soit supérieure à  $2.3/\alpha(\lambda)$  , c'est-à-dire supérieure à 3.8cm.

Par ailleurs, dans un mode de réalisation préféré, ledit système de pompage 8 comporte des modules (ou empilements) de diodes 8A, formés de semi-conducteurs issus de différents disques (waffers). La somme des émissions spectrales des différents semi-conducteurs engendre ainsi un spectre plus large que celui d'une diode unique. De plus, de préférence, chaque module de diodes 8A comporte un moyen de refroidissement individuel (non représenté), ce qui permet d'obtenir un fonctionnement également étalé du spectre.

En outre, dans un mode de réalisation particulier, ledit système de pompage 8 est formé de manière à engendrer un faisceau de pompage 3 qui comporte une stabilité de l'énergie déposée stable à plus de 20% sur plusieurs dizaines de degrés.

Par ailleurs, ladite source laser 8 comporte, de plus, des moyens (non représentés) pour engendrer au moins un double passage du faisceau de pompage 3 dans l'élément actif 1.

Les diodes de pompage 8A peuvent ne pas être refroidies activement, mais dissiper leur énergie, pendant une séquence limitée dans le temps, dans une structure solidaire, dont la montée en température va limiter leur propre élévation de température. La température de départ et cette élévation de température peuvent être telles que leur longueur d'onde d'émission, pendant toute la séquence, reste comprise dans la

plage spectrale de fonctionnement de sorte que, malgré une température éventuellement basse au départ de la séquence, et une dérive de cette température au cours du temps, le laser garde un fonctionnement assez stable au cours de la séquence sans utiliser de moyen actif de stabilisation de la température.

## REVENDICATIONS

1. Elément actif (I, II, III) pour source laser (7), comportant :

- un barreau allongé (2) à surface latérale (5) réfléchissante, dopé pour être susceptible d'absorber au moins un faisceau de pompage (3) se propageant au moins approximativement longitudinalement dans ledit barreau (2) afin d'amplifier au moins un rayonnement laser (4) se propageant également longitudinalement ; et
- une enveloppe au contact de ladite surface latérale (5) dudit barreau (2) et présentant un indice de réfraction plus petit que celui dudit barreau (2),

caractérisé en ce que :

- ladite enveloppe (6) est apte à réfléchir au moins 80% dudit faisceau de pompage (3) dans ledit barreau (2) ;
- la longueur et le dopage dudit barreau (2) sont tels que la fraction de l'énergie dudit faisceau de pompage (3), absorbée par ledit barreau (2), est au moins égale à 80% ; et
- dans ladite surface latérale réfléchissante (5) dudit barreau (2), est pratiquée au moins une zone diffusante (19, 20 ; 20.1, 20.2) apte à interrompre les trajets de modes laser parasites se propageant dans ledit barreau (2) par réflexions totales internes sur ladite surface latérale (5).

2. Elément actif selon la revendication 1,

caractérisé en ce que la surface latérale (5) dudit barreau (2) est polie pour assurer une réflexion totale dudit faisceau de pompage et en ce que ladite zone diffusante (19, 20 ; 20.1, 20.2) correspond à une zone dépolie de ladite surface latérale (5).

3. Elément actif selon l'une des revendications 1 ou 2,

caractérisé en ce que la fraction de l'énergie de pompage absorbée est supérieure à 80% sur une gamme spectrale supérieure à 15 nanomètres.

4. Elément actif selon l'une des revendications 1 à 3,  
caractérisé en ce que l'étendue totale de ladite zone diffusante sur ledit barreau (2) est au moins approximativement comprise entre 5% et 40% de la surface latérale (5) dudit barreau (2).

5 5. Elément actif selon l'une des revendications 1 à 4,  
caractérisé en ce que ladite zone diffusante comporte au moins une partie (19) de forme annulaire entourant ledit barreau (2).

6. Elément actif selon la revendication 5,  
caractérisé en ce que l'étendue longitudinale (L) de ladite partie annulaire 10 (19) de zone diffusante est au moins égale au diamètre ( $\phi$ ) dudit barreau (2).

7. Elément actif selon l'une des revendications 5 ou 6,  
caractérisé en ce que ladite partie annulaire (19) de zone diffusante est disposée dans une portion du barreau dans laquelle ne transite qu'un faible 15 flux de faisceau de pompage (3).

8. Elément actif selon la revendication 7, dans lequel un faisceau de pompage (3) est adressé audit barreau (2) par une seule (E1) des faces d'extrémité longitudinale de celui-ci,  
caractérisé en ce que ladite partie annulaire (19) de zone diffusante est 20 disposée au voisinage de l'autre (E2), desdites faces d'extrémité longitudinale dudit barreau (2).

9. Elément actif selon la revendication 7, dans lequel un faisceau de pompage (3.1 ; 3.2) est adressé audit barreau (2) par chacune des faces d'extrémité longitudinale (E1 ; E2) de celui-ci,  
25 caractérisé en ce que ladite partie annulaire (19) de zone diffusante est disposée au voisinage de la partie médiane dudit barreau (2).

10. Elément actif selon l'une des revendications 5 à 9,  
caractérisé en ce que ladite zone diffusante comporte de plus au moins une partie (20 ; 20.1, 20.2) en forme de bande, de direction générale au

moins approximativement longitudinale par rapport audit barreau (2), apte à interrompre les trajets laser parasites bouclés à l'intérieur de celui-ci.

11. Elément actif selon la revendication 10,  
caractérisé en ce que ladite partie en forme de bande est composée de  
5 segments individuels, disposés sur des génératrices différentes dudit bar-  
reau (2).

12. Elément actif selon la revendication 10,  
caractérisé en ce que ladite partie en forme de bande s'enroule en spirale  
sur la longueur dudit barreau.

10 13. Elément actif selon l'une des revendications 1 à 12,  
caractérisé en ce que ladite enveloppe (6) est formée par un film fluide,  
dont l'épaisseur est au plus égale à 500 µm.

14. Elément actif selon la revendication 13,  
caractérisé en ce que ladite enveloppe (6) est absorbante des rayonne-  
ments laser.

15. Source laser (7) comportant :  
– un élément actif (1) pour source laser ;  
– un système de pompage (8) muni de diodes laser de pompage (8A) qui  
sont susceptibles d'émettre au moins un faisceau de pompage (3 ; 3.1 ;  
20 3.2) ;  
– un système optique de transport (9) pour diriger le faisceau de pompage  
émis par lesdites diodes laser dans ledit élément actif (1) de manière à  
obtenir un pompage longitudinal ; et  
– une cavité optique (10) permettant d'extraire au moins un rayonnement  
25 laser (4),  
caractérisée en ce que ledit élément actif (1) est tel que spécifié sous  
l'une quelconque des revendications 1 à 14.

16. Source laser (7) selon la revendication 15,  
caractérisée en ce que ledit système de pompage (8) comporte des mo-  
dules de diodes (8A), formés de semi-conducteurs issus de différents dis-  
ques.

1/3

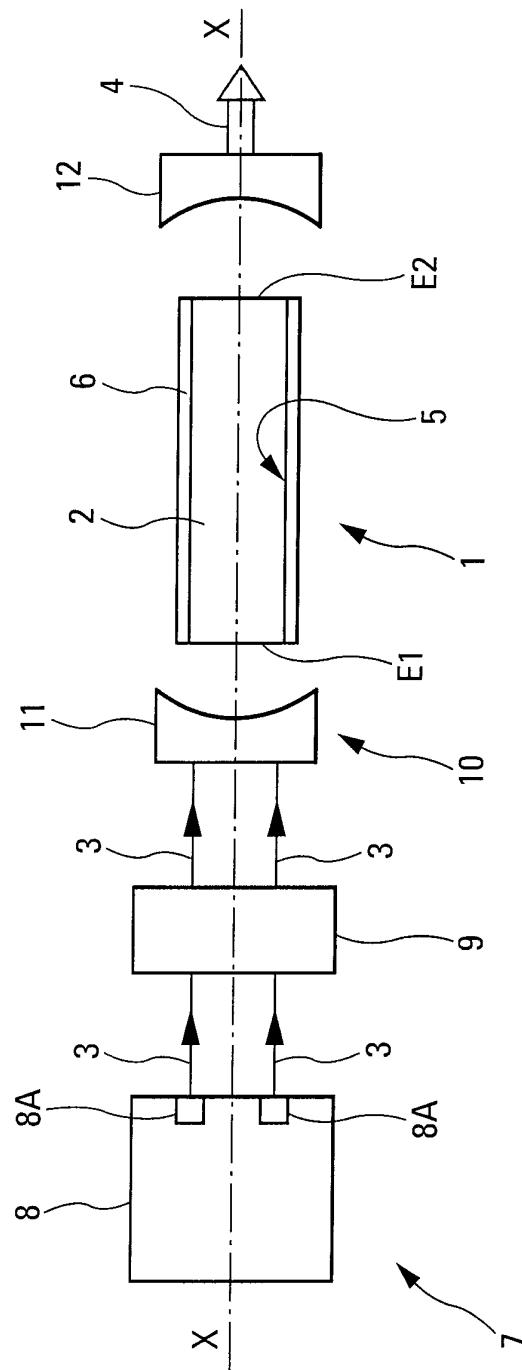


Fig.

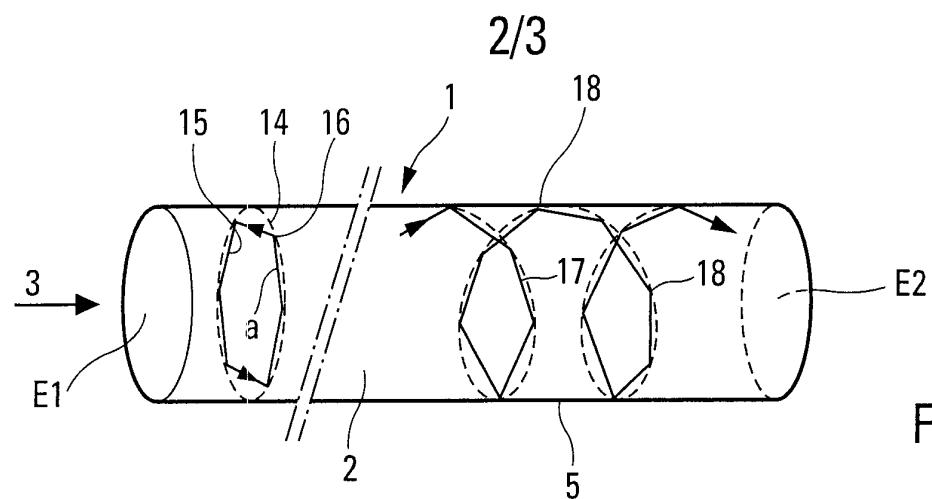


Fig. 2

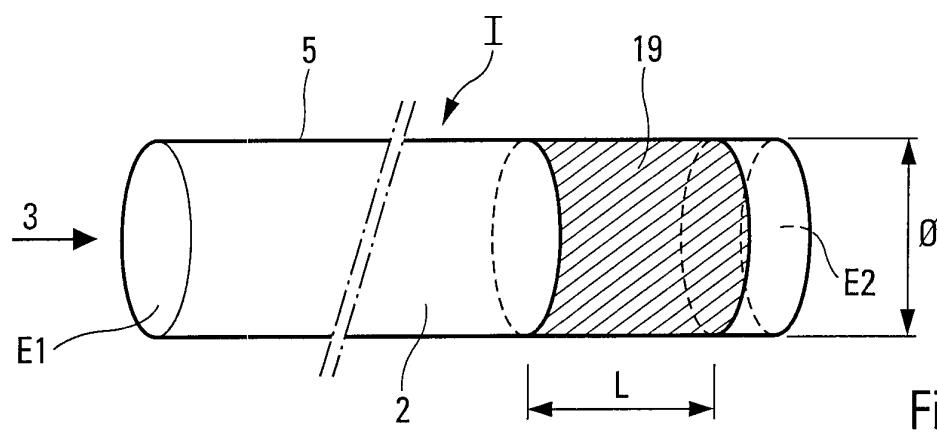


Fig. 3

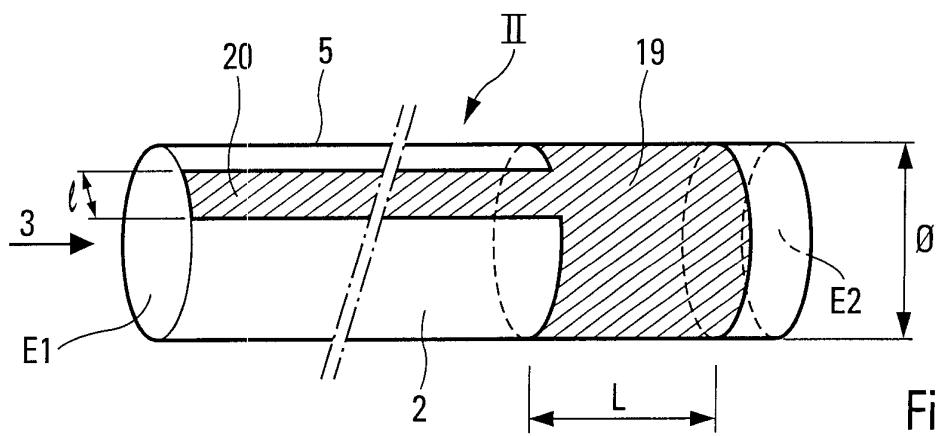


Fig. 4

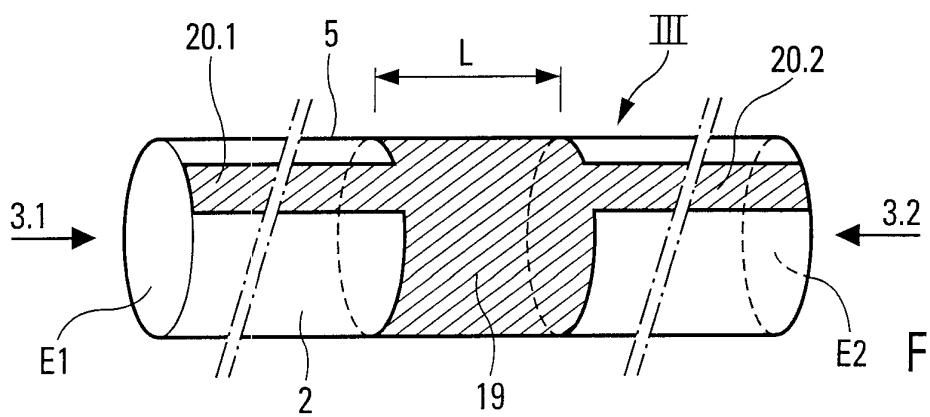


Fig. 5

3/3

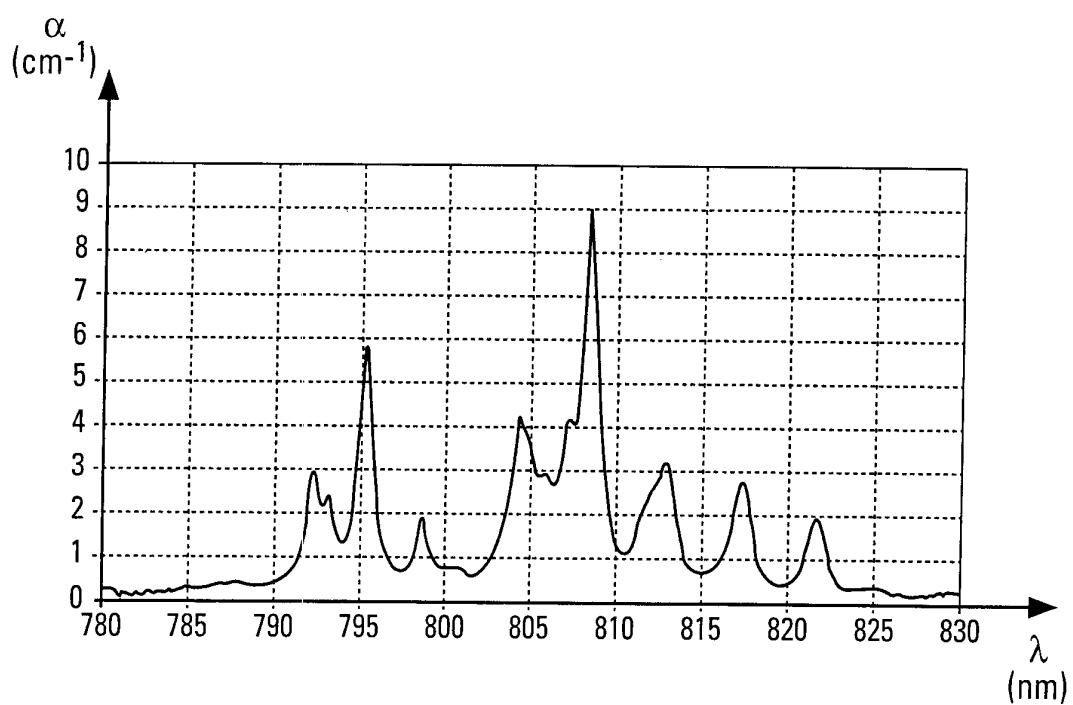


Fig. 6

**RAPPORT DE RECHERCHE  
PRÉLIMINAIRE**
N° d'enregistrement  
nationalFA 696663  
FR 0704168établi sur la base des dernières revendications  
déposées avant le commencement de la recherche

<b>DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS</b>		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
X	FR 2 885 267 A (CIE IND DES LASERS CILAS SA [FR]) 3 novembre 2006 (2006-11-03) * le document en entier * En particulier la figure 1 et les passages de la description associés* figure 1 * -----	1-16	H01S3/14
A	PÉREZ-MILLÁN P ET AL: "Active Q-switched distributed feedback erbium-doped fiber lasers" APPLIED PHYSICS LETTERS, AIP, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS, MELVILLE, NY, US, vol. 87, no. 1, 28 juin 2005 (2005-06-28), pages 11104-11104, XP012075482 ISSN: 0003-6951 * le document en entier * -----	1-16	
A	FR 1 490 528 A (LABO CENT TELECOMMUNICAT) 4 août 1967 (1967-08-04) * le document en entier * -----	1-16	
A	IMENKOV A N ET AL: "THE SPECTRAL LINewidth OF TUNABLE SEMICONDUCTOR INASB/INASSBP LASERS EMITTING AT 3.2-3.6 MUM (2800-3100 CM-1)" REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS, AIP, MELVILLE, NY, US, vol. 72, no. 4, avril 2001 (2001-04), pages 1988-1992, XP001102179 ISSN: 0034-6748 * le document en entier * -----	1-16	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (IPC) H01S
D,A	US 2005/018743 A1 (VOLODIN BORIS LEONIDOVICH [US] ET AL) 27 janvier 2005 (2005-01-27) * le document en entier * ----- -/-	1-16	
3	Date d'achèvement de la recherche <b>4 février 2008</b>	Examinateur <b>Bésuelle, Emmanuel</b>	
EPO FORM 1503 12.99 (P04C14)	CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire	T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons ..... & : membre de la même famille, document correspondant	



# RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications déposées avant le commencement de la recherche

**N° d'enregistrement  
national**

FA 696663  
FR 0704168

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
A,D	EP 1 115 186 A (CIE IND DES LASERS CILAS [FR]) 11 juillet 2001 (2001-07-11) * le document en entier * -----	1-16	
DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (IPC)			
Date d'achèvement de la recherche		Examinateur	
4 février 2008		Bésuelle, Emmanuel	
<b>CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS</b> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul  Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie  A : arrière-plan technologique  O : divulgation non-écrite  P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention  E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure.  D : cité dans la demande  L : cité pour d'autres raisons  &amp; : membre de la même famille, document correspondant</p>			

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE  
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 0704168 FA 696663**

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.

Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du **04-02-2008**

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)			Date de publication
FR 2885267	A	03-11-2006	AUCUN			
FR 1490528	A	04-08-1967	AUCUN			
US 2005018743	A1	27-01-2005	US 2006256827 A1			16-11-2006
			US 2006256830 A1			16-11-2006
			US 2006256831 A1			16-11-2006
			US 2006256832 A1			16-11-2006
			US 2006251143 A1			09-11-2006
			US 2006251134 A1			09-11-2006
			US 2006251142 A1			09-11-2006
EP 1115186	A	11-07-2001	FR 2803697 A1			13-07-2001
			IL 140430 A			12-05-2004
			JP 2001217489 A			10-08-2001
			US 2001019570 A1			06-09-2001